

2SC1975

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

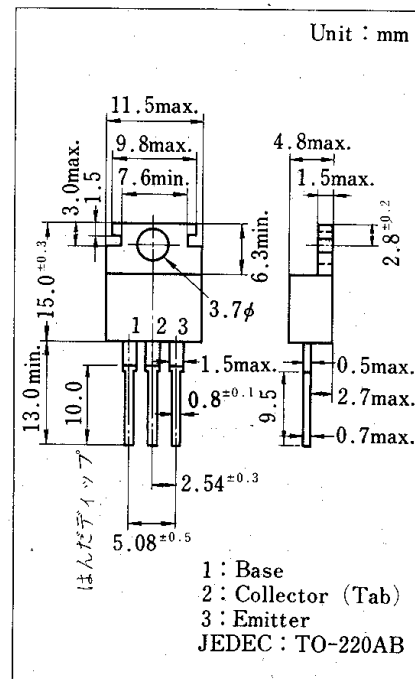
トランシーバ送信出力用/Transceiver Power Output

特 徴/Features

- 破壊強度が大きい。/Withstands worst overload conditions.
- 高耐圧/ $V_{CBO}=120V$

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧 ($R_{BE}=100\Omega$)	V_{CER}	90	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	3	A
コレクタ電流	I_C	2	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ C$)	P_C	12	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^\circ C$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=1mA, I_E=0$	120			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CER}	$I_C=2mA, R_{BE}=100\Omega$	90			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\mu A, I_C=0$	5			V
コレクタしゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=40V, I_B=0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	50		200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=0.2A$		0.6	1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=500mA$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1kHz$		40		pF
出力電力	P_o	$V_{CC}=13.5V, f=27MHz, P_{in}=0.2W$	3.8	4.2		W